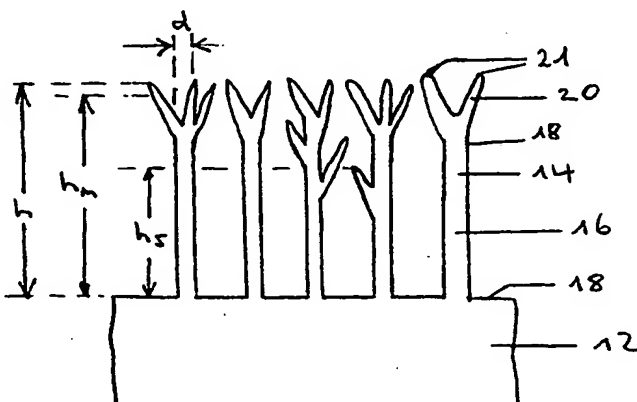


**PCT**WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM  
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE  
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

<b>(51) Internationale Patentklassifikation 7 :</b> <b>G01N 21/65, G01J 3/44</b>	<b>A1</b>	<b>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/08445</b> <b>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:</b> 17. Februar 2000 (17.02.00)
<b>(21) Internationales Aktenzeichen:</b> PCT/EP99/05280 <b>(22) Internationales Anmeldedatum:</b> 23. Juli 1999 (23.07.99) <b>(30) Prioritätsdaten:</b> 98810748.8 4. August 1998 (04.08.98) EP <b>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):</b> ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG [CH/CH]; CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH). <b>(72) Erfinder; und</b> <b>(75) Erfinder/Anmelder (nur für US):</b> SCHLOTTIG, Falko [DE/CH]; Unterer Rainweg 15, CH-4414 Fülinsdorf (CH). MEYER, Norbert [DE/DE]; Carl-von-Ossietzky 23, D-09126 Chemnitz (DE). TEXTOR, Marcus [CH/CH]; Abendstrasse 15, CH-8200 Schaffhausen (CH). SCHNAUT, Ulrich [DE/DE]; Steisslingerstrasse 22, D-78239 Rielasingen (DE). PAULET, Jean-François [CH/CH]; Grabenstrasse 39, CH-8225 Siblingen (CH). SEKINGER, Kurt [CH/CH]; Dammbodenstrasse 1, CH-8604 Volketswil (CH). <b>(74) Gemeinsamer Vertreter:</b> ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG; CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).		<b>(81) Bestimmungsstaaten:</b> BY, JP, RU, US.  <b>Veröffentlicht</b> <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
<b>(54) Title:</b> CARRIER SUBSTRATE FOR RAMAN-SPECTROSCOPY ANALYSES <b>(54) Bezeichnung:</b> TRÄGERSUBSTRAT FÜR RAMAN-SPEKTROMETRISCHE ANALYSEN <b>(57) Abstract</b> <p>The invention relates to a carrier substrate for the surface-enhanced Raman-spectroscopy analysis of substances. The carrier substrate contains a support layer (12) and a plurality of nano-bodies (14) which are formed against at least one side of the support layer. Each nano-body (14) has a rod-shaped parent area (16) which rests on the support layer (12) and at least two, preferably between 2 and 4, branching elements (20) which are formed against the parent area (16). The branching element (20) density is at least <math>10^8/\text{cm}^2</math>. The invention also relates to a method for producing carrier substrates for the surface-enhanced Raman-spectroscopy analysis of substances. Said method relates to the preparation of a porous moulded body (22) by anodic oxidation of a metal substrate (24). After coating of said moulded body (22) with the desired carrier substrate material and removal of the moulded body (22) by etching, a carrier substrate is obtained which comprises a plurality of nano-bodies (14) formed against a support layer (12). Each nano-body (14) has a maximum cross-sectional diameter (d) of between 10 and 250 nm and a height (h) of between 30 nm and 5 <math>\mu\text{m}</math>.</p> 		

### (57) Zusammenfassung

Trägersubstrat für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen. Das Trägersubstrat enthält eine Trägerschicht (12) und eine Vielzahl von Nanokörpern (14), welche wenigstens an eine Seite der Trägerschicht angeformt sind. Jeder Nanokörper (14) weist einen an die Trägerschicht (12) anliegenden, stabförmigen Stammbereich (16) und wenigstens zwei, vorzugsweise 2 bis 4, an den Stammbereich (16) angeformte Verzweigungselemente (20) auf. Die Dichte der Verzweigungselemente (20) beträgt mindestens  $10^8/\text{cm}^2$ . Weiter wird ein Verfahren zur Herstellung von Trägersubstraten für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen beschrieben. Das Verfahren betrifft die Herstellung eines porösen Formkörpers (22) durch anodische Oxidation eines Metallsubstrates (24). Nach Beschichtung des Formkörpers (22) mit dem gewünschten Trägersubstratmaterial und dem nachfolgenden Wegätzen des Formkörpers (22) resultiert ein Trägersubstrat, welches eine Vielzahl von an eine Trägerschicht (12) angeformte Nanokörper (14) enthält. Jeder Nanokörper (14) weist einen maximalen Querschnittsdurchmesser (d) zwischen 10 und 250 nm und eine Höhe (h) von 30 nm bis 5  $\mu\text{m}$  auf.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

### Trägersubstrat für Raman-spektrometrische Analysen

Vorliegende Erfindung betrifft ein Trägersubstrat für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen, enthaltend eine Trägerschicht und eine Vielzahl  
5 von Nanokörpern, welche wenigstens an eine Seite der Trägerschicht angeformt sind. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Herstellung eines Trägersubstrates für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen, enthaltend eine Trägerschicht und eine Vielzahl von an die Trägerschicht angeformten Nanokörpern mit jeweils wenigstens einer endständigen Spitze, wobei jeder Nanokörper einen maximalen Quer-  
10 schnittsdurchmesser zwischen 10 und 250 nm und eine Höhe von 30 nm bis 5 µm aufweist und die Dichte der endständigen Spitzen mindestens  $10^8/\text{cm}^2$  beträgt.

Die Raman-Spektrometrie dient der qualitativen und quantitativen chemischen Analyse von Substanzen. Dabei wird eine Substanz mit einer intensiven, monochromatischen elektro-  
15 magnetischen Strahlung, beispielsweise mit Laserlicht, bestrahlt. Dazu wird üblicherweise elektromagnetische Strahlung aus dem sichtbaren oder ultravioletten Spektralbereich verwendet. Die zu untersuchende Substanz kann in Form eines Gases, einer Flüssigkeit oder eines Festkörpers vorliegen. Bei der Messung des gestreuten Lichtes mit einem Spektrographen, d.h. bei der Bestimmung der Strahlungsintensität des gestreuten Lichtes in Funktion  
20 der Wellenlänge, erhält man ein Spektrum, welches aus einer starken Linie, der sogenannten Erregerlinie, und sehr viel schwächeren Linien, den sogenannten Raman-Linien, zu beiden Seiten der starken Linie besteht. Die Erregerlinie weist diesselbe Wellenzahl auf wie die einfallende Strahlung. Die Raman-Linien entsprechen jeweils spezifischen Rotations- oder Schwingungszuständen der zu untersuchenden Substanz. Die Raman-Linien sind auf einer  
25 Wellenzahlskala gegenüber der Erregerlinie symmetrisch angeordnet. Zudem weisen die Raman-Linien gegenüber der Erregerlinie eine typischerweise  $10^{-3}$  bis  $10^{-4}$  fach kleinere Intensität auf, wobei die Intensitäten der Raman-Linien auf der niederfrequenten Seite gegenüber denen auf der höherfrequenten Seite üblicherweise wesentlich grösser sind.

30 Die Unterschiede der Frequenzen zwischen Raman-Linien und Erregerlinie sind von der Frequenz der Erregerlinie unabhängig. Dagegen hängt die Intensität der Streustrahlung stark von der Frequenz der Erregerstrahlung ab.

Das Raman-Spektrum, d.h. die Sequenzen der Raman-Linien, sind für jede Substanz charakteristisch. Eine Verbindung kann durch Vergleich seines Raman-Spektrums mit den Spektren  
35 geeigneter, bekannter Verbindungen identifiziert werden. Dafür stehen umfangreiche systematisch geordnete Spektrensammlungen zur Verfügung. Die quantitative Analyse beruht auf

der Messung der Intensitäten von Raman-Linien der zu bestimmenden Substanz, wobei die Intensität proportional zur Konzentration der Substanz ist. Weiter lassen sich mit der Raman-Spektrometrie auch Strukturanalysen durchführen, da Strukturbausteine von Molekülen, wie beispielsweise Carbonyl-, Hydroxyl- oder Methylgruppen, jeweils charakteristische Gruppen-  
5 frequenzen aufweisen.

Die Raman-Spektren erfassen die Rotations- und Schwingungsfrequenzen der Substanzbausteine, so dass sich dadurch u.a. Aussagen über Polarisierbarkeiten, chemische Bindungskräfte und Atomabstände in Molekülen gewinnen lassen. Die Raman-Linien entstehen durch  
10 die inelastische Streuung von Lichtquanten an den Molekülen, wobei die Moleküle angeregt werden bzw. angeregte Moleküle in einen Zustand geringerer Energie übergehen. Die Raman-Linien treten auf, wenn sich die Polarisierbarkeiten bei den Schwingungen und Rotationen ändern.

15 Eine Hauptschwierigkeit bei der Raman-Spektrometrie liegt in der geringen Intensität der Raman-Linien. Diese Schwierigkeit kann beispielsweise durch die Verwendung hochenergetischer Laser oder durch Verwendung grosser Mengen der zu untersuchenden Substanz verringert werden. Der Einsatz eines hochenergetischen Lasers weist neben den hierzu notwendigen, hohen Investitionskosten auch den Nachteil auf, dass empfindliche Substanzen be-  
20 schädigt werden können, oder die zu untersuchende Substanz kann sich durch die hohe Energiezufuhr eines Hochleistungslasers in ihrer Struktur, beispielsweise durch chemische Reaktionen wie Verbrennung, verändern.

In einer speziellen Ausführungsform der Raman-Spektrometrie, der sogenannten Oberflächen-verstärkten Raman-Spektrometrie oder im Englischen Sprachgebrauch als 'Surface Enhanced Raman Spectroscopy' (SERS) oder als 'Surface Enhanced Resonance Raman Spectroscopy' (SERRS) bezeichnet, wird bei bestimmter Ausgestaltung von Trägersubstrat-  
25 oberflächen eine markante Intensitätserhöhung der Raman-Linien von an der Trägersubstratoberfläche adsorbierten Substanzen, beispielsweise Molekülen, beobachtet. Die Erhöhung der  
30 Intensität der Ramanstreuung bei der Oberflächen-verstärkten Raman-Spektrometrie gegenüber der Raman-Spektrometrie ohne Oberflächen-Verstärkung liegt in der Grössenordnung von  $10^6$ . Der Effekt der Erhöhung der Streuintensität hängt dabei stark von der Rauigkeit und der räumlichen Ausbildung der Rauigkeitsstruktur auf der Trägersubstratoberfläche ab.

35 Die Oberflächen-verstärkte Raman-Streuung basiert wesentlich auf einer Nanokörper aufweisenden Rauigkeitsstruktur, d.h. einer Trägersubstratoberfläche mit submikronen Strukturelementen. Dabei weisen die submikronen Strukturelemente Abmessungen im Submikro-

meterbereich auf. Die submikronen Strukturelemente können bei Bestrahlung der darauf adsorbierten Substanz mit einer elektromagnetischen Erregerstrahlung infolge elektronischer und/oder chemischer Wechselwirkungen zwischen Adsorbat, d.h. der zu untersuchenden Substanz, und der die Nanokörper aufweisenden Trägersubstratoberfläche zu einer Über-  
5 höhung der lokalen Feldstärke führen. Demzufolge hängt die Wechselwirkung, welche zur Oberflächen-verstärkten Raman-Streuung führt, einerseits von der strukturellen und materiellen Ausbildung der Trägersubstratoberfläche und andererseits auch von der elektronischen Struktur der darauf adsorbierten Substanz ab. Die zur Oberflächen-verstärkten Raman-Streuung führende Wechselwirkung kann einerseits durch eine klassische, elektromagnetische  
10 Verstärkung beschrieben werden, welche über die Zunahme der Amplitude des lokalen elektromagnetischen Feldes beschrieben wird und üblicherweise den grössten Teil der Verstärkung bewirkt, und andererseits durch eine chemische Verstärkung, die zu einer Verstärkung der Wechselwirkung in einer ersten Monolage der adsorbierten Substanz führt, wobei in dieser ersten Monolage auch Ladungs-Transfer-Übergänge zwischen der Substanz und dem  
15 Trägersubstrat stattfinden können.

Die Oberflächen-verstärkte Raman-Streuung ist weiter abhängig von der verwendeten Erregerstrahlung, sowie vom Verhältnis der Nanokörperabmessungen zur Wellenlänge der Erregerstrahlung. Zur Erreichung einer maximalen Intensität der Raman-Linien muss weiter die  
20 Dichte der auf dem Trägersubstrat befindlichen Nanokörper möglichst hoch sein. Zudem muss die Gesamtheit der Nanokörper eine optimale Grössenverteilung aufweisen. Bei optimaler Wahl der genannten Parameter wird die Wechselwirkung zwischen der auf der Trägersubstratoberfläche adsorbierten Substanz und der elektromagnetischen Erregerstrahlung maximal.

25

In der EP 0 484 425 B1 wird ein Trägersubstrat für die Oberflächen-verstärkte Raman-Spektrometrie beschrieben, welches eine auf ein Substrat deponierte, zusammenhängende, dielektrische Rauigkeitsschicht mit einer Dicke von mindestens 170 nm und eine durchgehend auf dieser ersten Schicht abgelagerten zweiten Schicht enthält, und die zweite Schicht  
30 eine Vielzahl von Metallnadeln aufweist, wobei die Metallnadeln eine Länge von mindestens 350 nm und einer Breite von mindestens 50 nm aufweisen, und die Dichte der Metallnadeln mindestens  $70 \cdot 10^8/\text{cm}^2$  beträgt. Im weiteren beschreibt die EP 0 484 425 B1 ein Verfahren zur Herstellung derartiger Trägersubstrate, wobei die dielektrische Schicht, sowie die zweite Schicht mit den Metallnadeln durch Vakuumdeposition auf die Substratoberfläche abgeschie-  
35 den werden. Die Bildung der Metallnadeln wird dadurch erreicht, dass das Metall in einem bestimmten Winkel und mit einer vorgegebenen Aufdampftrate auf die dielektrische Schicht aufgedampft wird.

Aufgabe vorliegender Erfindung ist die Bereitstellung von gegenüber dem Stand der Technik einfacher herzustellenden Trägersubstraten für die Oberflächen-verstärkte Raman-Spektrometrie, welche zudem einen weiter erhöhten Anteil der Oberflächen-verstärkten Raman-  
5 Streuung bewirken.

Erfindungsgemäss wird diese Aufgaben dadurch gelöst, dass jeder Nanokörper einen an die Trägerschicht anliegenden, stabförmigen Stammbereich und wenigstens zwei, vorzugsweise 2 bis 4, an den Stammbereich angeformte Verzweigungselemente aufweist, und die Dichte der  
10 Verzweigungselemente mindestens  $10^8/\text{cm}^2$  beträgt.

Die Nanokörper befinden sich an wenigstens einer Seite der Trägerschicht. Bevorzugt liegen alle Nanokörper jedoch an ein und derselben Seite der Trägerschicht. Die Nanokörper weisen weiter bevorzugt wenigstens in einem von der Trägerschicht abragenden Teil einen orthogo-  
15 nal zur Trägerschicht liegenden Stammbereich auf. Besonders bevorzugt werden Nanokörper, deren ganzer stabförmiger Stammbereich orthogonal zur Trägerschicht-Oberfläche liegt.

Die Nanokörper weisen bevorzugt einen maximalen Querschnittsdurchmesser zwischen 10 und 250 nm, insbesondere zwischen 10 und 150 nm, und eine Höhe von 30 nm bis 5  $\mu\text{m}$ , ins-  
20 besondere von 30 nm bis 2  $\mu\text{m}$ , auf. Dabei variiert die Höhe der einzelnen Nanokörper bevorzugt um nicht mehr als  $\pm 5\%$ , insbesondere um nicht mehr als  $\pm 3\%$ , von der über alle Nanokörper gemittelten Höhe, wobei unter der Höhe eines Nanokörpers die maximale, orthogonal zur Oberfläche der Trägerschicht gemessene Abmessung des Nanokörpers, d.h. des Stammbereiches zusammen mit den angeformten Verzweigungselementen, verstanden  
25 wird.

Bevorzugt sind die Nanokörper im wesentlichen vollflächig über die eine Seite der Trägerschicht verteilt. Dabei ist die Verteilung der Nanokörper ganz bevorzugt homogen. Die Dichte der von den Stammbereichen der Nanokörper abragenden Verzweigungselemente  
30 beträgt zweckmässigerweise mindestens  $10^8/\text{cm}^2$ . Weiter bevorzugt weisen die erfindungsgemässen Trägersubstrate eine Dichte der Verzweigungselemente von  $10^8$  bis  $10^{12}/\text{cm}^2$  auf.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weisen 95 % aller Verzweigungselemente eine gleichmässige Höhe auf, wobei gleichmässige Höhe bedeutet, dass diese um nicht mehr  
35 als  $\pm 5\%$  der über das gesamte Substrat gemittelten Höhe der Verzweigungselemente variiert. Als Höhe eines Verzweigungselementes wird die maximale, orthogonal zur Oberfläche der Trägerschicht gemessene Abmessung des Verzweigungselementes verstanden.

Die Nanokörper und/oder die Trägerschicht bestehen beispielsweise aus Ni, Al, Pd, Pt, W, Fe, Ta, Rh, Cd, Cu, Au, Ag, In, Co, Sn, Si, Ge, Te, Se, oder einer chemischen Verbindung enthaltend wenigstens einen dieser Stoffe, wie beispielsweise Sn- oder InSn-Oxid, oder einer

- 5 Legierung der vorgenannten Metalle. Weiter können die Trägerschicht und/oder die Nanokörper aus einem der vorstehend genannten Materialien bestehen, wobei zusätzlich eine Metallschicht, insbesondere aus Au oder Ag, deponiert werden kann. Bevorzugt bestehen die Nanokörper und die Trägerschicht aus demselben Material. Dabei bestehen die Trägerschicht und die Nanokörper besonders bevorzugt aus Au oder Ag.

10

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist die Trägerschicht zwischen den Nanokörpern eine mechanische Stützschiicht auf, welche aus einem Material, bevorzugt aus einem Oxid und insbesondere aus Aluminiumoxid besteht. Zweckmässigerweise misst die Schichtdicke der mechanischen Stützschiicht weniger als die über die ganze Trägerschicht gemittelten

- 15 Höhe der Stammbereiche aller Nanokörper und insbesondere weniger als die Hälfte dieser gemittelten Höhe der Stammbereiche.

Die erfindungsgemässen Trägersubstrate eignen sich hervorragend für die Oberflächen-verstärkte Raman-Spektrometrie, da die einzelnen Verzweigungselemente, wie auch der

- 20 Stammbereich der Nanokörper als die Raman-Streuung verstärkende submikrone Strukturelemente dienen können und durch die dadurch realisierte, sehr hohe Zahl von submikronen Strukturelementen die Intensität der Raman-Linien stark, d.h. gegenüber der Raman-Spektrometrie ohne Oberflächen-Verstärkung um mehr als den Faktor  $10^6$ , erhöht wird.

- 25 Eine weitere Aufgabe vorliegender Erfindung besteht in der Angabe eines gegenüber dem Stand der Technik einfacheren und kostengünstigeren Verfahrens zur Herstellung bekannter Trägersubstrate für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen, sowie in der Angabe eines Verfahrens zur Herstellung der erfindungsgemässen Trägersubstrate.

30

Die auf das Verfahren gerichtete Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass

- a) in einem ersten Schritt ein Formkörper mit einer zur gewünschten Trägersubstratoberfläche spiegelbildlichen Formkörperoberfläche dadurch geschaffen wird, dass ein Substratkörper aus einem anodisierbaren Metall anodisch in einem das betreffende
- 35 Metalloxid rücklösenden Elektrolyten oxidiert wird, wodurch wenigstens auf einer Substratkörperoberfläche eine Formschiicht aus Metalloxid, enthaltend eine an die

Substratkörperoberfläche anliegende Sperrschicht und eine dieser anliegenden, porösen Schicht, gebildet wird, und die poröse Schicht die zu den gewünschten Nanokörpern spiegelbildlich ausgebildeten Poren-Kavitäten enthält;

- 5 b) in einem zweiten Schritt die Formkörperoberfläche durch chemische und/oder elektrolytische Methoden ganzflächig derart beschichtet wird, dass die Poren-Kavitäten vollständig mit einem Beschichtungsmaterial ausgefüllt werden und zudem eine die Poren-Kavitäten verbindende Trägerschicht aus einem Beschichtungsmaterial gebildet wird, und die Trägerschicht eine zusammenhängende, mechanisch tragende Schicht darstellt;
- 10 c) und in einem dritten Schritt der Formkörper derart entfernt wird, dass zumindest die endständigen Spitzen frei liegen.

Der für die erfindungsgemässe Herstellung von Trägersubstraten für die Oberflächenverstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen notwendige Formkörper mit einer zur gewünschten Trägersubstratoberfläche im wesentlichen spiegelbildlichen Formkörperoberfläche besteht zweckmässigerweise aus einem Substratkörper und einer Formschicht, wobei letztere die zur gewünschten Trägersubstratoberfläche im wesentlichen spiegelbildliche Oberflächenstruktur enthält.

Der Substratkörper besteht bevorzugt aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung und stellt bevorzugt einen Teil eines Stückgutes, beispielsweise eines Profiles, Balkens oder eine andere Form von Stücken, einer Platte, eines Bandes, Bleches oder einer Folie aus Aluminium dar, oder eine Aluminium-Deckschicht eines Verbundwerkstoffes, insbesondere als Aluminiumdeckschicht einer Verbundplatte, oder betrifft eine auf einen beliebigen Werkstoff -- beispielsweise elektrolytisch -- aufgebrachte Aluminiumschicht, wie beispielsweise eine plattierte Aluminiumschicht. Weiter bevorzugt betrifft der Substratkörper ein Werkstück aus Aluminium, welches z.B. durch ein Walz-, Extrusions-, Schmiede- oder Fliesspressverfahren hergestellt wird. Der Substratkörper kann auch durch Biegen, Tiefziehen, Kaltfliesspressen oder dergleichen umgeformt sein.

30 Mit dem Werkstoff Aluminium sind in vorliegendem Text Aluminium aller Reinheitsgrade, sowie alle handelsüblichen Aluminiumlegierungen umfasst. Beispielsweise umfasst der Begriff Aluminium alle Walz-, Knet-, Guss-, Schmiede- und Presslegierungen aus Aluminium. Zweckmässigerweise besteht der Substratkörper aus Reinaluminium mit einem Reinheitsgrad von gleich oder grösser 98.3 Gew.-% oder Aluminiumlegierungen mit wenigstens einem der Elemente aus der Reihe von Si, Mg, Mn, Cu, Zn oder Fe. Der Substratkörper aus Reinaluminium kann beispielsweise aus Aluminium einer Reinheit von 98.3 Gew.-% und höher,



zweckmässig 99.0 Gew.-% und höher, bevorzugt 99.9 Gew.-% und höher und insbesondere 99.95 Gew.-% und höher, und dem Rest handelsübliche Verunreinigungen bestehen.

Neben Aluminium genannter Reinheiten kann der Substratkörper auch aus einer Aluminium-  
5 legierung bestehen, enthaltend 0.25 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere 0.5 bis 2 Gew.-%, Magnesium oder enthaltend 0.2 bis 2 Gew.-% Mangan oder enthaltend 0.5 bis 5 Gew.-% Magnesium und 0.2 bis 2 Gew.-% Mangan, insbesondere z.B. 1 Gew.-% Magnesium und 0.5 Gew.-% Mangan oder enthaltend 0.1 bis 12 Gew.-%, vorzugsweise 0.1 bis 5 Gew.-%, Kupfer oder enthaltend 0.5 bis 5 Gew.-% Zink und 0.5 bis 5 Gew.-% Magnesium oder enthaltend  
10 0.5 bis 5 Gew.-% Zink, 0.5 bis 5 Gew.-% Magnesium und 0.5 bis 5 Gew.-% Kupfer oder enthaltend 0.5 bis 5 Gew.-% Eisen und 0.2 bis 2 Gew.-% Mangan, insbesondere z.B. 1.5 Gew.-% Eisen und 0.4 Gew.-% Mangan.

Die Formschicht besteht bevorzugt aus Aluminiumoxid. Die Herstellung einer für das erfindungsgemässe Verfahren erforderlichen Formschicht erfolgt bevorzugt durch anodische Oxi-  
15 dation der Substratkörperoberfläche in einem Elektrolyten unter Poren bildenden Bedingungen. Erfindungswesentlich ist dabei, dass die Poren gegen die freie Oberfläche hin offen sind. Vorteilhaft ist die Porenverteilung über die Oberfläche gleichmässig. Die Schichtdicke der Formschicht beträgt zweckmässigerweise 50 nm bis 5 µm und bevorzugt 50 nm bis 2 µm.

20

Die Herstellung der Formschicht geschieht beispielsweise durch anodische Oxidation der Substratkörperoberfläche in einem das Aluminiumoxid rücklösenden Elektrolyten. Die Elektrolyttemperatur beträgt zweckmässigerweise zwischen - 5 und 85 °C, bevorzugt zwischen 15 und 80 °C und insbesondere zwischen 30 und 70 °C. Zur Durchführung der anodischen  
25 Oxidation kann der Substratkörper oder wenigstens dessen Oberflächenschicht oder zumindest der Teil der Substratkörperoberfläche, der mit einer Formschicht versehen werden soll, in einen entsprechenden Elektrolyten gegeben und als positive Elektrode (Anode) geschaltet werden. Als negative Elektrode (Kathode) dient eine weitere in denselben Elektrolyten gegebene Elektrode aus beispielsweise rostfreiem Stahl, Blei, Aluminium oder Graphit.

30

Üblicherweise wird die Substratkörperoberfläche vor dem erfindungsgemässen Verfahren einer Vorbehandlung unterzogen, wobei beispielsweise die Substratkörperoberfläche zuerst entfettet, dann gespült und schliesslich gebeizt wird. Das Beizen wird beispielsweise mit einer Natriumhydroxidlösung mit einer Konzentration von 50 bis 200 g/l bei 40 bis 60 °C während  
35 einer bis zehn Minuten durchgeführt. Anschliessend kann die Oberfläche gespült und mit einer Säure, wie beispielsweise Salpetersäure, insbesondere einer Konzentration von 25 bis

35 Gew.-% bei Raumtemperatur, d.h. typischerweise im Temperaturbereich 20 - 25 °C, während 20 bis 60 s neutralisiert und erneut gespült werden.

Die Eigenschaften einer mittels anodischer Oxidation hergestellten Oxidschicht, wie beispielsweise die Porendichte und der Porendurchmesser, hängen weitgehend von den Anodisierungsbedingungen wie beispielsweise Elektrolytzusammensetzung, Elektrolyttemperatur, Stromdichte, Anodisierspannung und Anodisdauer, sowie vom anodisierten Grundwerkstoff ab. Während der anodischen Oxidation in sauren Elektrolyten bildet sich an der Substratkörperoberfläche eine im wesentlichen porenfreie Grund- oder Sperrschicht und eine poröse Aussenschicht, die während der anodischen Oxidation an ihrer freien Oberfläche durch Rücklösung zum Teil chemisch wieder aufgelöst wird. Dadurch entstehen in der Aussenschicht Poren, die im wesentlichen vertikal zur Substratkörperoberfläche liegen und gegen die freie Oberfläche der Oxidschicht hin offen sind. Die Dicke der Oxidschicht erreicht ihren Maximalwert, wenn sich Wachstum und Rücklösung die Waage halten, was beispielsweise von der angelegten Anodisierspannung, der Elektrolytzusammensetzung, der Stromdichte, der Elektrolyttemperatur, Anodisdauer, sowie vom anodisierten Grundwerkstoff abhängt.

Für die Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens werden bevorzugt Elektrolyte verwendet, welche eine oder mehrere anorganische und/oder organische Säuren enthalten. Weiter bevorzugt werden Anodisierspannungen von 10 bis 100 V und Stromdichten von 50 bis 3000 A/m<sup>2</sup>. Die Anodisdauer beträgt typischerweise 1 bis 1000 s, zweckmässigerweise 1 bis 240 s, insbesondere 1 bis 20 s.

Das Anlegen der Anodisierspannung geschieht beispielsweise durch kontinuierliche Erhöhung der angelegten Spannung bis zum jeweiligen vorbestimmten, zeitlich konstanten Wert. Die Stromdichte erhöht sich dabei ebenfalls in Funktion der angelegten Anodisierspannung, erreicht zeitlich nach dem Erreichen der jeweils vorbestimmten, konstanten Spannung einen Maximalwert und fällt dann langsam ab.

Die Schichtdicke der Sperrschicht ist spannungsabhängig und liegt beispielsweise im Bereich 8 bis 16 Angström/V und insbesondere zwischen 10 und 14 Angström/V. Der Porendurchmesser der porösen Aussenschicht ist ebenfalls spannungsabhängig und beträgt beispielsweise zwischen 8 und 13 Angström/V und insbesondere 10 bis 12 Angström/V.

Der Elektrolyt kann beispielsweise eine starke organische oder anorganische Säure oder ein Gemisch starker organischer und/oder anorganischer Säuren enthalten. Typische Beispiele solcher Säuren sind Schwefelsäure (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), oder Phosphorsäure (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>). Weitere Säuren,

die angewendet werden können, sind beispielsweise Chromsäure, Oxalsäure, Sulfaminsäure, Malonsäure, Maleinsäure oder Sulfosalicylsäure. Auch Gemische genannter Säuren können verwendet werden. Für das erfindungsgemässe Verfahren werden beispielsweise Schwefelsäure in Mengen von 40 bis 350 g/l und bevorzugt 150 bis 200 g/l eingesetzt (Schwefelsäure bezogen auf 100% Säure). Es kann als Elektrolyt auch Phosphorsäure in einer Menge von 60 bis 300 g/l und insbesondere 80 bis 150 g/l angewendet werden, wobei die Säuremenge auf 100 % reine Säure bezogen ist. Ein anderer bevorzugter Elektrolyt ist Schwefelsäure in Mischung mit Oxalsäure, wobei insbesondere eine Menge von 150 bis 200 g/l Schwefelsäure mit beispielsweise 5 bis 25 g/l Oxalsäure gemischt wird. Weiter bevorzugt werden Elektrolyte enthaltend beispielsweise 250 bis 300 g/l Maleinsäure und beispielsweise 1 bis 10 g/l Schwefelsäure. Ein weiterer Elektrolyt enthält beispielsweise 130 bis 170 g/l Sulfosalicylsäure in Mischung mit 6 bis 10 g/l Schwefelsäure.

Für die Herstellung der erfindungsgemässen Trägersubstrate, welche mehrere Verzweigungselemente enthalten, wird die im ersten Verfahrensschritt durchzuführende Oxidation der Substratkörperoberfläche in mehreren Anodisierschritten durchgeführt, wobei in einem ersten Anodisierschritt die Anodisierspannung kontinuierlich oder schrittweise von 0 auf einen ersten Wert  $U_1$  erhöht wird, und in einem weiteren, beispielsweise zweiten Anodisierschritt die Anodisierspannung kontinuierlich oder schrittweise auf einen zweiten, gegenüber  $U_1$  kleineren Wert  $U_2$  reduziert wird. Bevorzugt wird dabei die Anodisierspannung zur Bildung von zylinder- oder kegelmumpfförmigen, langen Poren-Stammgebieten auf einen ersten Wert  $U_1$  zwischen 12 und 80 V eingestellt und nachfolgend zur Bildung wenigstens zweier Porenverzweigungen pro Poren-Stammgebiet am gegen die Substratoberfläche gerichteten Ende jeder Pore auf einen zweiten Wert  $U_2$  zwischen 10 und 20 V reduziert.

Die Poren weisen in ihrer vertikalen Ausdehnung einen gegen die Oberfläche der Formschicht gerichteten Stammgebiet und einen gegen den Substratkörper gerichteten Verzweigungsbereich auf, d.h. jede im wesentlichen vertikal zur Oberfläche der Formschicht liegende Pore besteht aus einer länglichen, gegen die freie Oberfläche der Formschicht offenen Pore, die sich im Verzweigungsbereich in wenigstens zwei, vorzugsweise 2 bis 4 Vertiefungen oder Porenverzweigungen aufteilt. Zweckmässigerweise weisen die Poren im Stammgebiet einen Durchmesser von 10 bis 250 nm, bevorzugt zwischen 10 und 150 nm und insbesondere zwischen 40 und 130 nm auf. Die Porenzahl, d.h. die Zahl der Poren im Stammgebiet, beträgt zweckmässigerweise  $10^8$  Poren/cm<sup>2</sup> und höher, bevorzugt  $10^8$  bis  $10^{12}$  Poren/cm<sup>2</sup> und insbesondere  $10^9$  bis  $10^{11}$  Poren/cm<sup>2</sup>. Die mittlere Dichte der Formschicht beträgt bevorzugt 2.1 bis 2.7 g/cm<sup>3</sup>. Weiter bevorzugt weist die Formschicht eine Dielektrizitätskonstante zwischen 5 und 7.5 auf.

Nach dem Anodisierverfahren kann die Oberfläche der Formschicht weiteren Behandlungen, wie z.B. chemisch oder elektrolytisch Ätzen, Plasmaätzen, Spülen oder Imprägnieren, zugeführt werden.

5

Die fertiggestellte Formschicht wird ganzflächig derart beschichtet, dass die in der porösen Schicht des Formkörpers vorhandenen Poren-Kavitäten vollständig mit dem Beschichtungsmaterial ausgefüllt werden, und eine die Nanokörper verbindende Trägerschicht gebildet wird, und die Trägerschicht eine zusammenhängende, mechanisch tragende Schicht darstellt.

10

Für die Beschichtung der Formkörperoberfläche können beispielsweise Ni, Al, Pd, Pt, W, Fe, Ta, Rh, Cd, Cu, Au, Ag, In, Co, Sn, Si, Ge, Se, Te, oder eine chemische Verbindung enthaltend wenigstens eines dieser Elemente, oder eine Legierung vorstehend aufgeführter Metalle verwendet werden. Bevorzugt werden metallische Beschichtungsmaterialien und insbesondere Beschichtungen aus Au oder Ag.

15

Die Beschichtung der Formkörperoberfläche kann beispielsweise durch chemische oder elektrolytische Methoden, oder durch PVD (Physical Vapour Deposition) oder CVD (Chemical Vapour Deposition) geschehen. Bevorzugt wird eine chemische und/oder elektrolytische Abscheidung des Beschichtungsmaterials, wobei zweckmässigerweise die Porenkavitäten zuvor chemisch aktiviert werden.

20

Bevorzugt erfolgt die im zweiten Verfahrensschritt durchzuführende Beschichtung der Formkörperoberfläche in drei Stufen, wobei in einer ersten Stufe die Formkörperoberfläche und insbesondere die Poren-Kavitäten elektrolytisch mit Beschichtungsmaterial bekeimt werden, in einer zweiten Stufe durch eine stromlose, chemische Abscheidung die Poren-Kavitäten vollständig mit Beschichtungsmaterial gefüllt werden und die chemische Abscheidung von Beschichtungsmaterial solange weitergeführt wird, bis auf der zwischen den Poren-Kavitäten liegenden Formkörperoberfläche eine Schicht von 100 nm bis 2 µm aus Beschichtungsmaterial gebildet ist, und in einer dritten Stufe diese Beschichtung galvanisch solange verstärkt wird, bis eine Beschichtungs-Schichtdicke von 10 bis 20 µm resultiert.

30

Als weiterer erfindungswesentlicher Verfahrensschritt werden die Nanokörper, insbesondere deren Verzweigungselemente, durch vollständiges oder teilweises Entfernen der Formschicht freigelegt.

35

Das vollständige Freilegen der Nanokörper, d.h. das Trennen der Trägerschicht mit den angeformten Nanokörpern vom Formkörper, kann beispielsweise durch vollständiges Weg-  
ätzen des Formkörpers geschehen. In einer bevorzugten Ausführung wird jedoch nur die  
Formschicht chemisch weggeätzt, so dass die Trägerschicht mit den angeformten Nano-  
5 körnern vom Formkörper vollständig getrennt wird und damit in Form eines erfindungs-  
gemässen Trägersubstrates vorliegt.

In einer weiteren bevorzugten Ausführung wird nur ein Teil der Formschicht weggeätzt, so  
dass auf der Trägerschicht zwischen den Stammbereichen der Nanokörper die Formschicht  
10 stehen bleibt und eine mechanische Stützsicht bildet. Dies geschieht beispielsweise durch  
chemisches Wegätzen des Substratkörpers, der Sperrschicht und eines Teils der porösen  
Schicht. Der poröse Teil der Formschicht muss jedoch derart entfernt werden, dass die Ver-  
zweigungselemente der Nanokörper vollständig freiliegen.

15 In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemässen Verfahrens werden  
die freigelegten Nanokörper einem Ätzprozess unterworfen, beispielsweise durch Plasma-  
ätzen, oder durch chemisches oder elektrolytisches Ätzen. Damit kann beispielsweise die  
Gestalt der Verzweigungselemente und/oder der Stammbereiche hinsichtlich der Ober-  
flächen-verstärkten Raman-Spektrometrie optimiert werden.

20

Weiter kann im Rahmen einer Nachbehandlung der erfindungsgemässen Nanokörper auch  
eine zusätzliche, dünnen Metallschicht deponiert werden, welche die Gestalt der Nanokörper  
und der Verzweigungselemente derart verändert, dass deren Eigenschaften für die Ober-  
flächen-verstärkte Raman-Spektrometrie einer bestimmten, zu untersuchenden Substanz  
25 optimiert werden. Diese zusätzliche, dünne Metallschicht besteht bevorzugt aus einem Edel-  
metall, insbesondere aus Au oder Ag. Die Deposition dieser zusätzlichen Metallschicht kann  
beispielsweise durch chemische oder elektrolytische Methoden, durch PVD (Physical Vapour  
Deposition), wie beispielsweise Sputtern oder Elektronenstrahlverdampfen, oder durch CVD  
(Chemical Vapour Deposition) geschehen.

30

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung finden sich in den Unteransprüchen.

Das erfindungsgemässe Verfahren erlaubt die kostengünstige Herstellung von Trägersubstra-  
ten für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen. Das  
35 Verfahren erlaubt insbesondere die reproduzierbare Herstellung solcher Trägersubstrate in  
grossen Mengen und konstanter Qualität.

Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele für die Herstellung von erfindungsgemässen Trägersubstraten beschrieben. Alle Angaben in Teilen oder Prozents beziehen sich auf das Gewicht, sofern nichts anderes angegeben ist.

## 5 Erstes Ausführungsbeispiel

Als Substratkörper dient ein Aluminiumblech aus 99.9 Gew.-% Al mit glänzender Oberfläche. Das Aluminiumblech wird in einer milden alkalischen Entfettungslösung gereinigt, in Wasser gespült, in Salpetersäure dekapiert, in Wasser gespült, kurz in Ethanol getaucht und getrocknet.

10

Anschliessend wird auf der Rückseite des Bleches ein geeigneter Abdecklack aufgebracht und der derart vorbehandelte Substratkörper in einem Phosphorsäure-Elektrolyten mit einer Konzentration von 155 g/l  $H_3PO_4$  bei einer Elektrolyttemperatur von 68 °C mit Gleichstrom einer Stromdichte von 12 A/dm<sup>2</sup> während 10 Sekunden mit einer Anodisierspannung von 20 V anodisiert. Die resultierende Schichtdicke der Aluminiumoxidschicht beträgt typischerweise 100 nm.

Die Formschicht, d.h. die Aluminiumoxidschicht, weist nun Poren auf, die einen gegen die freie Oberfläche der Aluminiumoxidschicht ragenden, nach oben offenen Stammbereich aufweisen.

Der Formkörper, d.h. insbesondere die freie Oberfläche der Formschicht, wird nun mit Wasser gespült und in einem goldsalzhaltigen Aktivierungsbad (1 g/l  $H(AuCl_4) \cdot 3 H_2O$ , 7 g/l  $H_2SO_4$ ) mit einer angelegten Wechselspannung von 16 V während 5 bis 10 Sekunden behandelt und danach erneut mit Wasser gespült.

Die Poren der derart vorbereiteten Formschicht weisen am Porengrund eingelagerte Goldpartikel auf, welche bevorzugt als Keime für eine weitere selektive Goldabscheidung dienen. Die selektive Goldabscheidung, d.h. die weitere Ablagerung von Gold an die bereits in den Poren befindlichen Goldpartikel, geschieht vorerst auf chemischem Weg in einem Goldbad (Goldbad: Auruna® 516 der Firma Degussa enthaltend 4 g/l Au, pH 7.5) bei einer Temperatur von 70 °C. Die selektive Goldabscheidung dauert ca. 2 Stunden, wobei eine Goldschicht mit einer Schichtdicke von ca. 2 µm erzeugt wird. Die mit Gold beaufschlagte Formschicht wird nun wieder mit Wasser gespült und anschliessend wird die Goldschicht in einem handelsüblichen, galvanischen Goldbad (Goldbad: Auruna® 552 der Firma Degussa enthaltend 8 g/l Au, pH 6) mit einer Stromdichte von 0.4 A/dm<sup>2</sup> auf ca. 10 µm Au verstärkt.

Nach erneutem Spülen des mit Gold beschichteten Formkörpers mit Wasser wird der Abdecklack, beispielsweise chemisch oder durch Plasmaätzen, entfernt. Der Formkörper wird nun chemisch in Natronlauge (50 g/l NaOH) aufgelöst. Bei einer NaOH-Badtemperatur von 40 °C dauert dieser Vorgang mehrere Stunden, typischerweise ca. 12 Stunden.

Nach dem Entfernen des Formkörpers verbleibt das gewünschte Trägersubstrat mit den Nanokörpern, wobei die Nanokörper im wesentlichen dieselben Abmessungen wie die zuvor in der Formschicht vorhandenen Porenkavitäten aufweisen.

10

Das Trägersubstrat wird erneut mit Wasser gespült, in 5 %-ige Citronensäure bei 20 °C während 10 Minuten dekapiert, wieder mit Wasser gespült, in Ethanol gegeben und dann getrocknet.

15 Wird ein derart hergestelltes Trägersubstrat für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Anilin verwendet, wobei als Erregerstrahlung die 632.8 nm Linie eines Helium-Ion-Lasers verwendet wird und die Laserleistung 8 mW beträgt, wird ein Raman-Spektrum erhalten, welches die typischen Raman-Linien für Anilin auf Gold zeigt.

#### 20 Zweites Ausführungsbeispiel

Ein als Substratkörper dienendes Aluminiumblech, wie im ersten Ausführungsbeispiel beschrieben, wird entsprechend dem im ersten Ausführungsbeispiel beschriebenen Verfahren gereinigt.

25 Anschliessend wird auf der Rückseite des Bleches ein geeigneter Abdecklack aufgebracht und der derart vorbehandelte Substratkörper in einem Phosphorsäureelektrolyten mit einer Konzentration von 150 g/l  $H_3PO_4$  bei einer Elektrolyttemperatur von 35 °C mit Gleichstrom und einer Stromdichte von 120 A/m<sup>2</sup> während 6 Minuten anodisiert, wobei die Anodisierspannung kontinuierlich von 0 auf 50 V erhöht wird. Direkt anschliessend wird die Anodisierspannung in 5 bis 6 Stufen auf ca. 15 V abgesenkt, wobei die Spannungsabsenkungsstufen anfänglich klein sind und allmählich vergrössert werden. Nach Erreichen der Anodisierspannung von ca. 15 V wird diese während ca. 30 Sekunden aufrechterhalten. Die resultierende Schichtdicke der Aluminiumoxidschicht beträgt typischerweise 600 nm.

Der Formkörper, d.h. der anodisierte Substratkörper, weist nun Poren auf, die einen gegen die freie Formkörperoberfläche ragenden, nach oben offenen Stammbereich und einen gegen den Substratkörper gerichteten Verzweigungsbereich aufweisen.

- 5 Der Formkörper, d.h. insbesondere die freie Oberfläche der Formschicht, wird nun mit Wasser gespült und in einem goldsalzhaltigen Aktivierungsbad ( $1 \text{ g/l H(AuCl}_4) \cdot 3 \text{ H}_2\text{O}$ ,  $7 \text{ g/l H}_2\text{SO}_4$ ) mit einer angelegten Wechselspannung von 16 V während 5 bis 10 Sekunden behandelt und danach erneut mit Wasser gespült.
- 10 Die selektive Goldabscheidung erfolgt chemisch und anschliessend galvanisch, wie im ersten Ausführungsbeispiel beschrieben. Nach einem Spülvorgang mit Wasser wird entsprechend dem ersten Ausführungsbeispiel der Abdecklack entfernt, der Formkörper chemisch aufgelöst und somit das gewünschte Trägersubstrat aus Gold freigelegt.
- 15 Wie im ersten Anwendungsbeispiel beschrieben, wird das derart hergestellte Trägersubstrat mit den metallischen Nanokörpern für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Anilin verwendet, wobei die Raman-Spektren dieses ausgewählten Systems mit der 632.8 nm Linie eines Helium-Ion-Lasers aufgenommen werden. Die Laserleistung beträgt 8 mW. Die erhaltenen Spektren zeigen die typischen Raman-Linien für Anilin auf Gold.

20

#### Drittes Ausführungsbeispiel

Ein als Substratkörper dienendes Aluminiumblech, wie im ersten Ausführungsbeispiel beschrieben, wird entsprechend dem im ersten oder zweiten Ausführungsbeispiel beschriebenen Verfahren gereinigt und anodisiert. Der derart gebildete Formkörper wird gemäss dem ersten

- 25 Ausführungsbeispiel aktiviert.

- Die selektive Goldabscheidung erfolgt chemisch und anschliessend galvanisch, wie im ersten Ausführungsbeispiel beschrieben. Nach einem Spülvorgang mit Wasser wird entsprechend dem ersten Ausführungsbeispiel der Abdecklack entfernt, der Formkörper chemisch aufgelöst
- 30 und somit das gewünschte Trägersubstrat freigelegt.

- Die metallischen Nanokörper des Trägersubstrates werden nun einer elektrolytischen Nachbehandlung unterzogen, wobei der Durchmesser und die Länge bzw. Höhe der Nanokörper verkleinert wird. Für diese Nachbehandlung wird das Trägersubstrat in eine geeignete Halte-
- 35 rung gegeben und in  $1 \text{ M H}_2\text{SO}_4$  mit  $300 \mu\text{A/cm}^2$  während 10 Sekunden behandelt, danach



mit Wasser gespült und während 1 Minute in 5 M HCl behandelt. Danach wird das nachbehandelte Trägersubstrat wieder mit Wasser gespült.

Wie im ersten und zweiten Anwendungsbeispiel beschrieben, wird das derart hergestellte Trägersubstrat mit den metallischen Nanokörpern für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Anilin getestet, wobei die Raman-Spektren dieses ausgewählten Systems mit der 632.8 nm Linie eines Helium-Ion-Lasers aufgenommen werden. Die Laserleistung beträgt 8 mW. Die erhaltenen Spektren zeigen wiederum die typischen Raman-Linien für Anilin auf Gold.

10

Vorliegende Erfindung wird beispielhaft anhand der Figuren 1 bis 6 weiter erläutert.

Figur 1 zeigt schematisch einen Querschnitt eines nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Trägersubstrates für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen. Das Trägersubstrat enthält eine Trägerschicht 12, an welche auf einer Seite eine Vielzahl von Nanokörpern 14 angeformt sind. Die in Figur 1 dargestellten Nanokörper zeigen einen orthogonal von der Trägerschicht wegführenden Stammbereich 16, welcher jeweils an seinem freiliegenden Ende in eine einzige endständige Spitze 21 ausläuft. Die individuellen Nanokörper 14 weisen eine Höhe  $h$  und einen maximalen Querschnittsdurchmesser  $d$  auf, wobei der Querschnittsdurchmesser  $d$  der Nanokörper-Stammbereiche 16 in Abhängigkeit von der Höhe im wesentlichen konstant bleibt, d.h. die Nanokörper-Stammbereiche 16 sind im wesentlichen stabförmig ausgebildet. Zudem weisen alle Nanokörper 14 eine im wesentlichen gleiche Höhe  $h$  auf. Dabei bezeichnet  $h_D$  die über alle Nanokörper 14 gemittelte Höhe der Nanokörper. In der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform befindet sich zwischen den Nanokörpern 14 noch eine auf die Trägerschicht 12 deponierte, mechanische Stützschrift 15, welche die mechanisch wenig stabilen, langen und dünn ausgebildeten Nanokörper 14 stützt. Die Trägersubstratoberfläche 18 betrifft einerseits die Oberfläche der Nanokörper 14, sowie die zwischen den Nanokörpern 14 liegende Oberfläche der Trägerschicht 12, welche in Figur 1 jedoch von der mechanischen Stützschrift 15 bedeckt ist.

30

Figur 2 zeigt schematisch einen Querschnitt eines erfindungsgemässen Trägersubstrates für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen. Das Trägersubstrat enthält eine Trägerschicht 12. Auf der einen Seite der Trägerschicht 12 ist eine Vielzahl von Nanokörpern 14 angeformt. Die Nanokörper 14 weisen jeweils einen stabförmigen Stammbereich 16 und wenigstens zwei an den Stammbereich 16 angeformte Verzweigungselemente 20 auf. Die beiden in Figur 2 links aussen dargestellten Nanokörper 14, sowie der äusserste Nanokörper 14 auf der rechten Seite in Figur 2 zeigen beispielhaft jeweils endstän-

dig am Stammbereich 16 angeformte Verzweigungselemente 20. Die restlichen in Figur 2 dargestellten Nanokörper weisen neben den endständig am Stammbereich 16 angeformten Verzweigungselementen 20 noch weitere, nicht endständig an den Stammbereich angeformte Verzweigungselemente 20 auf. Jedes Verzweigungselement 20 weist an seinem frei liegenden  
5 Ende eine endständige Spitze 21 auf.

Die Höhe der einzelnen Nanokörper 14 ist in Figur 2 wiederum mit  $h$  und der maximale Querschnittsdurchmesser jedes Nanokörpers 14 mit  $d$  gekennzeichnet. Der maximale Querschnittsdurchmesser jedes Nanokörpers 14 liegt jeweils im Stammbereich 16, wobei der  
10 Stammbereich 16 stabförmig bis leicht kegelstumpfförmig ausgebildet ist, so dass der grösste maximale Querschnittsdurchmesser  $d$  üblicherweise im Trägerschicht-nahen Bereich des Nanokörpers 14 gemessen wird. Die Trägersubstratoberfläche 18 bezeichnet wiederum die gesamte Oberfläche des Trägersubstrates auf der Trägerschichtseite, welche die Nanokörper 14 enthält. Demnach umfasst die Trägersubstratoberfläche 18 einerseits die zwischen den  
15 Nanokörpern 14 liegende Trägerschichtoberfläche, sowie andererseits die gesamte Oberfläche der Nanokörper 14, d.h. deren Oberfläche bezüglich deren Stammbereiche 14 und der Verzweigungselemente 20.

Die maximale Höhe der einzelnen Verzweigungselemente 20, d.h. der maximale Abstand der  
20 endständigen Spitze 21 eines Verzweigungselementes 20 von der zwischen den Nanokörpern 14 liegenden Trägersubstratoberfläche 18, ist mit  $h_s$  bezeichnet. Die über alle auf der Trägerschicht 12 vorhandenen Nanokörper 14 gemittelte Höhe  $h_s$  aller Verzweigungselemente 20 ist mit  $h_m$  bezeichnet.

25 Figur 3 zeigt schematisch einen Querschnitt durch einen während dem erfindungsgemässen Verfahren bereitgestellten Formkörper 22. Der Formkörper 22 besteht aus dem Substratkörper 24 und einer Formschicht 26, wobei sich die Formschicht 26 aus einer porösen Schicht 30 und einer Sperrschicht 28 zusammensetzt. Die Sperrschicht 28 liegt einer Seite des Substratkörpers 24, der sogenannten Substratkörperoberfläche 25, an. Die poröse  
30 Schicht 30 enthält die Porenkavitäten 36, wobei die in Figur 3 dargestellten Porenkavitäten 36 eine zylinderförmige Gestalt aufweisen. Die frei liegende Oberfläche der Formschicht 26 beschreibt die Formkörperoberfläche 23, welche einerseits durch die Oberfläche der Porenkavitäten 36 und andererseits durch die zwischen den Porenkavitäten 36 frei liegende Oberfläche der porösen Schicht 30 definiert ist.

35

Ein gemäss Figur 3 gebildeter Formkörper 22 entsteht beispielsweise nach einer anodischen Oxidation einer metallenen Substratkörperoberfläche 25 mit einer konstanten oder konti-

nuierlich oder stufenweise steigenden Anodisierspannung in einem das Metalloxid rüchlösen-  
den Elektrolyten.

- Figur 4 zeigt schematisch einen Querschnitt durch einen während dem erfindungsgemässen  
5 Verfahren bereitgestellten Formkörper 22, nachdem - ausgehend von einem Formkörper 22  
gemäss Figur 3 - die anodische Oxidation der Substratkörperoberfläche 25 mit einer gegen-  
über der zuvor, d.h. für die Herstellung von Porenkavitäten gemäss Figur 3, angelegten  
Anodisierspannung tieferen Spannung weitergeführt wird.
- 10 Die in Figur 4 gezeigten, in der porösen Schicht 30 vorhandenen Porenkavitäten 36 weisen  
einen vertikal zur Substratkörperoberfläche 25 liegenden, nach oben offenen Poren-Stamm-  
bereich 32 und einen der Sperrschicht 28 anliegenden Poren-Verzweigungsbereich 33 auf.  
Die gezeigten Poren weisen im Verzweigungsbereich 33 jeweils zwei Porenverzweigungen  
34 auf.
- 15 Ein gemäss Fig. 4 ausgebildeter Formkörper 22 entsteht beispielsweise, wenn - ausgehend  
von einem Formkörper 22 gemäss Figur 3 - die anodische Oxidation mit einer tieferen  
Anodisierspannung weitergeführt wird. Dazu kann die Anodisierspannung - ausgehend von  
der für die Herstellung der zylinderförmigen Porenkavitäten 32, 36 angelegten Anodisier-  
20 spannung - stufenweise oder kontinuierlich abgesenkt werden. Da der sich während der  
anodischen Oxidation bildende Porendurchmesser, sowie die sich ausbildende Schichtdicke  
der Sperrschicht 28 von der Grösse der Anodisierspannung abhängen, verringert sich  
während einer solchen zweiten Verfahrensstufe die Dicke der Sperrschicht 28, wobei die  
Schichtdicke der porösen Oxidschicht 30 weiter wächst. Da die Bildung der Oxidschicht 28,  
25 30 an der Grenzschicht zwischen Aluminium-Substratkörper 24 und Sperrschicht 28 statt-  
findet, und der Porendurchmesser Anodisierspannungs-abhängig ist, bilden sich anschliessend  
an den Poren-Stammbereich 32 mehrere Porenverzweigungen 34 mit einem gegenüber dem  
Stammbereich 32 kleineren Durchmesser.
- 30 Figur 5 zeigt schematisch den Querschnitt durch einen während dem erfindungsgemässen  
Verfahren bereitgestellten, mit Beschichtungsmaterial versehenen Formkörper 22. Der Form-  
körper 22 besteht aus einem Substratkörper 24 und einer Formschicht 26. Die poröse Schicht  
30 der Formschicht 26 enthält Poren, deren Porenkavitäten 36 einen Stammbereich 32 und  
einen Verzweigungsbereich 33 mit wenigstens zwei Porenverzweigungen 34 aufweisen. Die  
35 Porenkavitäten 36 sind vollständig mit Beschichtungsmaterial ausgefüllt. Das in den Poren-  
kavitäten 36 befindliche Beschichtungsmaterial bildet nach dem Entfernen der Formschicht  
26 die Nanokörper 14 des Trägersubstrates. Zudem befindet sich auf der Formschicht 26 eine

durchgehende, das in den Porenkavitäten 36 befindliche Beschichtungsmaterial verbindende Schicht aus Beschichtungsmaterial, welche nach dem Freilegen des Trägersubstrates die Trägerschicht 12 bildet.

- 5 Ein gemäss Figur 5 ausgebildeter, mit Beschichtungsmaterial versehender Formkörper 22 entsteht beispielsweise, wenn -- ausgehend von einem Formkörper 22 gemäss Fig. 4 - die Formkörperoberfläche 23 chemisch und/oder elektrolytisch aktiviert und nachfolgend durch chemische und/oder elektrolytische Verfahren mit Beschichtungsmaterial beaufschlagt wird.
- 10 Figur 6 zeigt schematisch den Querschnitt durch ein mittels dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Trägersubstrat für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen. Das Trägersubstrat weist eine Trägerschicht 12 und auf einer Seite der Trägerschicht 12 eine Vielzahl von Nanokörpern 14 auf. Die in Figur 6 dargestellten Nanokörper 14 weisen einen Stammbereich 16 und jeweils zwei Verzweigungselemente 20 auf, deren Längsachsen  $a_1$ ,  $a_2$  einen spitzen Winkel  $\alpha$  einschliessen. Zudem weist jedes Verzweigungselement 20 an den freiliegenden Enden eine endständige Spitze 21 auf. Die Stammbereiche 16 der Nanokörper 14 werden von einer zwischen diesen liegenden Stützs-  
15 schicht 15 mechanisch gestützt, wobei ein Teil der Stammbereiche 16 und die Verzweigungselemente 20 freiliegen.

20

Ein gemäss Figur 6 ausgebildetes Trägersubstrat entsteht beispielsweise, wenn - ausgehend von einem mit Beschichtungsmaterial versehenen Formkörper 22 gemäss Figur 5 -- der Substratkörper 24 und ein Teil der Formschicht 26 chemisch weggeätzt wird.

**Patentansprüche**

1. Trägersubstrat für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen, enthaltend eine Trägerschicht (12) und eine Vielzahl von Nanokörpern (14), welche wenigstens an eine Seite der Trägerschicht (12) angeformt sind,  
5 dadurch gekennzeichnet, dass  
jeder Nanokörper (14) einen an die Trägerschicht (12) anliegenden, stabförmigen Stammbereich (16) und wenigstens zwei, vorzugsweise 2 bis 4, an den Stammbereich (16) angeformte Verzweigungselemente (20) aufweist, und die Dichte der Verzweigungselemente (20) mindestens  $10^8/\text{cm}^2$  beträgt.  
10
2. Trägersubstrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Nanokörper (14) einen maximalen Querschnittsdurchmesser (d) zwischen 10 und 250 nm, insbesondere zwischen 10 und 150 nm, und eine Höhe (h) von 30 nm bis 5  $\mu\text{m}$ , insbesondere von 30 nm bis 2  $\mu\text{m}$ , aufweist.  
15
3. Trägersubstrat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe (h) der einzelnen stabförmigen Nanokörper (14) um nicht mehr als  $\pm 3 \%$  von der über alle stabförmigen Nanokörper (14) gemittelten Höhe ( $h_D$ ) variiert .  
20
4. Trägersubstrat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte der Verzweigungselemente (20)  $10^8$  bis  $10^{12}/\text{cm}^2$  beträgt.  
25
5. Trägersubstrat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 95 % aller Verzweigungselemente (20) die gleiche Höhe ( $h_S$ ) aufweisen, wobei gleiche Höhe ( $h_S$ ) bedeutet, dass die Höhe ( $h_S$ ) um nicht mehr als  $\pm 5 \%$  der über das gesamte Substrat gemittelten Höhe ( $h_M$ ) der Verzweigungselemente (20) variiert.  
30
6. Trägersubstrat nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Nanokörper (14) und die Trägerschicht (12) aus demselben Werkstoff bestehen, bevorzugt aus Metall, insbesondere aus Gold oder Silber.  
35
7. Verfahren zur Herstellung eines Trägersubstrates für die Oberflächen-verstärkte, Raman-spektrometrische Analyse von Substanzen, enthaltend eine Trägerschicht (12) und eine Vielzahl von an die Trägerschicht (12) angeformten Nanokörpern (14) mit jeweils wenigstens einer endständigen Spitze (21), wobei jeder Nanokörper (14) einen maximalen Querschnittsdurchmesser (d) zwischen 10 und 250 nm und eine Höhe (h) von 30 nm

bis 5 µm aufweist und die Dichte der endständigen Spitzen (21) mindestens 10<sup>8</sup>/cm<sup>2</sup> beträgt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 5 a) in einem ersten Schritt ein Formkörper (22) mit einer zur gewünschten Träger-substratoberfläche (18) spiegelbildlichen Formkörperoberfläche (23) dadurch geschaffen wird, dass ein Substratkörper (24) aus einem anodisierbaren Metall anodisch in einem das betreffende Metalloxid rücklösenden Elektrolyten oxidiert wird, wodurch wenigstens auf einer Substratkörperoberfläche (25) eine Formschicht (26) aus Metalloxid, enthaltend eine an die Substratkörperoberfläche (25) anliegende Sperrschicht (28) und eine dieser anliegenden, porösen Schicht (30), gebildet  
10 wird, und die poröse Schicht (30) die zu den gewünschten Nanokörpern (14) spiegelbildlich ausgebildeten Poren-Kavitäten (36) enthält;
  - b) in einem zweiten Schritt die Formkörperoberfläche (23) durch chemische und/oder elektrolytische Methoden ganzflächig derart beschichtet wird, dass die Poren-Kavi-  
15 tätäten (36) vollständig mit einem Beschichtungsmaterial ausgefüllt werden und zudem eine die Poren-Kavitäten (36) verbindende Trägerschicht (12) aus einem Beschichtungsmaterial gebildet wird, und die Trägerschicht (12) eine zusammenhängende, mechanisch tragende Schicht darstellt;
  - c) und in einem dritten Schritt der Formkörper (22) derart entfernt wird, dass zumin-  
20 dest die endständigen Spitzen (21) frei liegen.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Substratkörper (24) aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung besteht.
  - 25 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die im ersten Verfahrensschritt durchzuführende Oxidation des Substrates (24) in mehreren Anodisierschritten erfolgt, wobei in einem ersten Anodisierschritt die Anodisierspannung kontinuierlich oder schrittweise von 0 auf einen ersten Wert U<sub>1</sub> erhöht wird, und in einem weiteren Anodisierschritt die Anodisierspannung kontinuierlich oder schrittweise auf einen zwei-  
30 ten, gegenüber U<sub>1</sub> kleineren Wert U<sub>2</sub> reduziert wird.
  10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Wert U<sub>1</sub> der Anodisierspannung zur Bildung von zylinder- oder kegelstumpfförmigen, langen Porenstambbereichen (32) zwischen 12 und 80 V liegt, und der zweite Wert U<sub>2</sub> der Anodisierspannung zur Bildung wenigstens zweier Porenverzweigungen (34) pro Poren-  
35

Stammbereich (32) am gegen die Substratkörperoberfläche (25) gerichteten Ende jeder Pore (36) zwischen 10 und 20 V beträgt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die im  
5 zweiten Verfahrensschritt durchzuführende Beschichtung der Formkörperoberfläche (23) durch chemische und/oder elektrolytische Methoden geschieht.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die im zweiten Verfahrensschritt durchzuführende Beschichtung der Formkörperoberfläche (23) in drei Stufen  
10 erfolgt, wobei in einer ersten Stufe die Formkörperoberfläche (23) und insbesondere die Poren-Kavitäten (36) elektrolytisch mit Beschichtungsmaterial bekeimt werden, in einer zweiten Stufe durch eine stromlose, chemische Abscheidung die Poren-Kavitäten (36) vollständig mit Beschichtungsmaterial gefüllt werden und die chemische Abscheidung  
15 von Beschichtungsmaterial solange weitergeführt wird, bis auf der zwischen den Poren-Kavitäten (36) liegenden Formkörperoberfläche (23) eine Schicht von 100 nm bis 2 µm aus Beschichtungsmaterial gebildet ist, und in einer dritten Stufe die Beschichtung galvanisch solange verstärkt wird, bis eine Beschichtungs-Schichtdicke von 10 bis 20 µm gebildet ist.
- 20 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass als Beschichtungsmaterial Gold oder Silber gewählt wird.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das im  
25 dritten Verfahrensschritt durchzuführende Entfernen des Formkörpers (22) durch chemisches Wegätzen der Formschicht (26) geschieht.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das im  
30 dritten Verfahrensschritt durchzuführende Entfernen des Formkörpers (22) in zwei Stufen geschieht, wobei zuerst der gesamte Substratkörpers (24) chemisch weggeätzt wird, und in einer zweiten Stufe zumindest ein Teil der Formschicht (26) durch chemisches Ätzen oder durch Plasmaätzen entfernt wird.
16. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Nano-  
35 körper (14) durch eine Nachbehandlung mittels chemischer oder elektrolytischer Ätzung oder durch Plasmaätzen, oder mittels Deposition einer zusätzlichen, dünnen Schicht, insbesondere aus Gold oder Silber, hinsichtlich ihrer Oberflächen-verstärkenden Eigenschaften für die Raman-Spektrometrie optimiert werden.

1 / 3

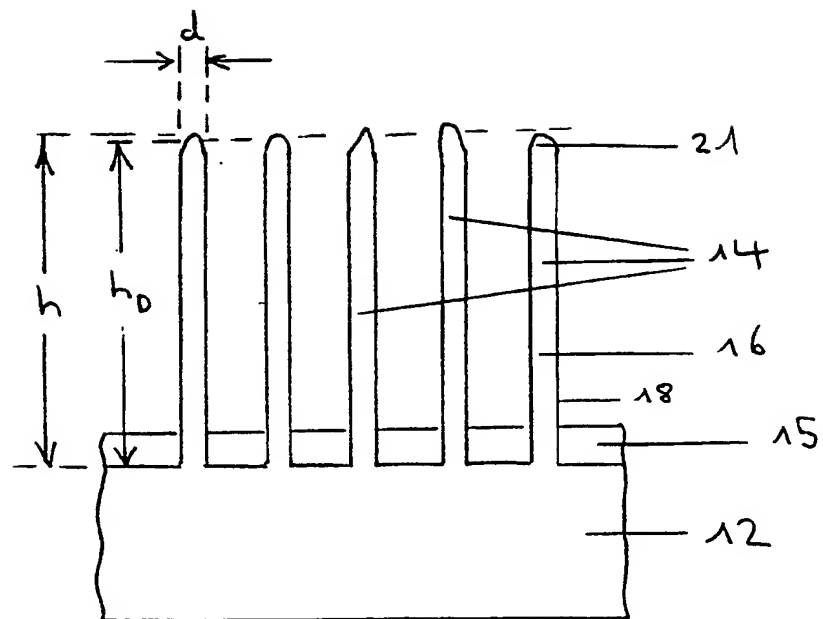


Fig. 1

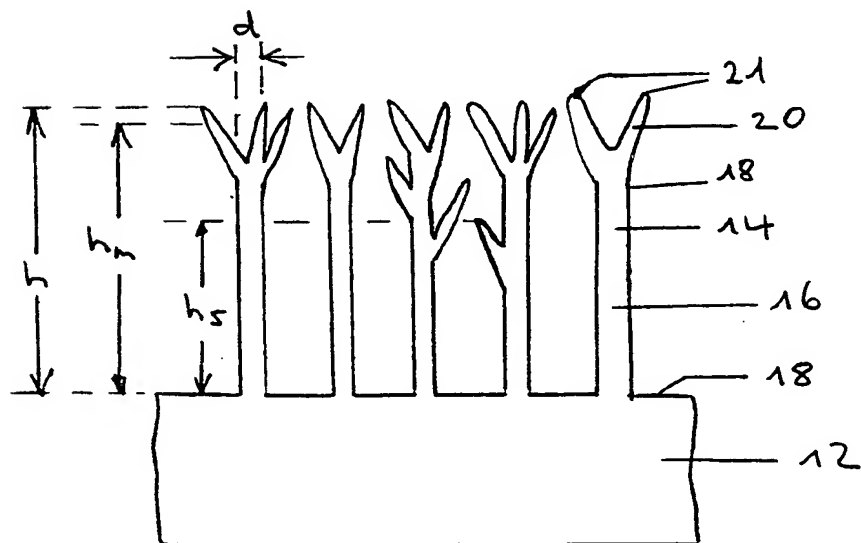


Fig. 2



2 / 3

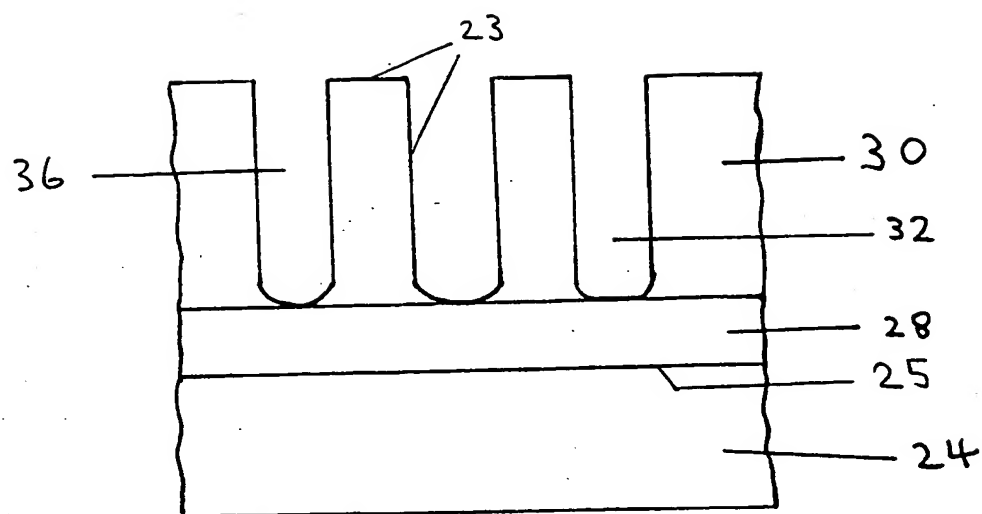


Fig. 3

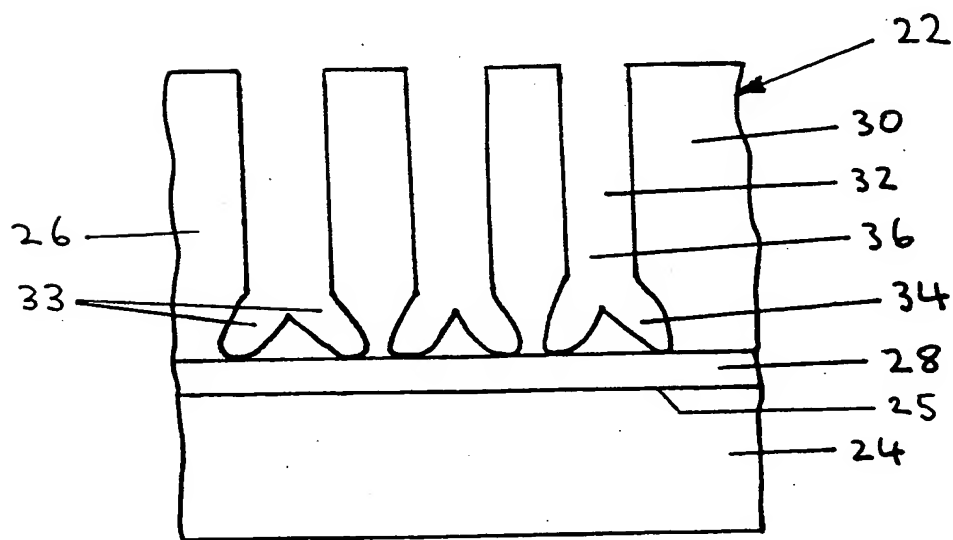


Fig. 4

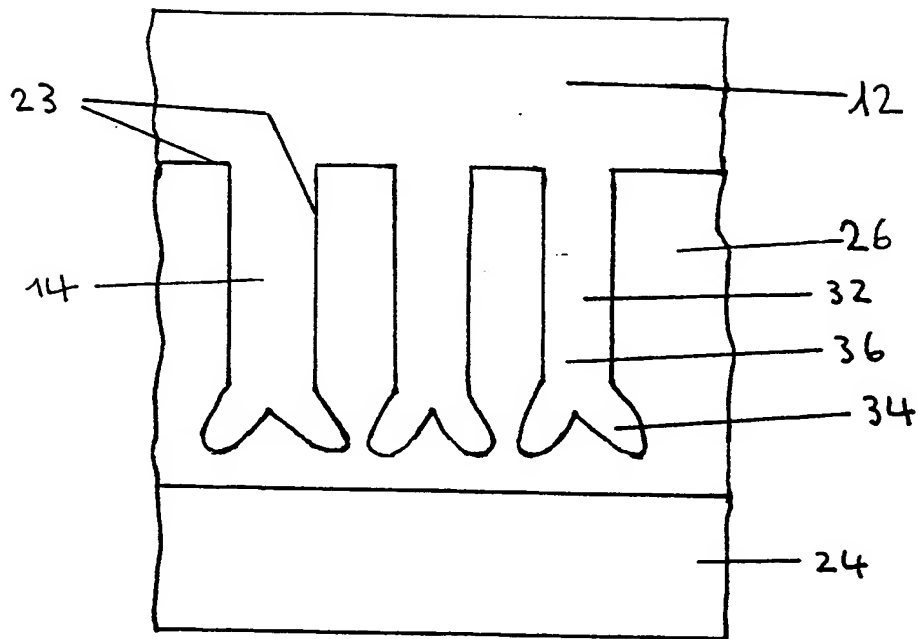


Fig. 5

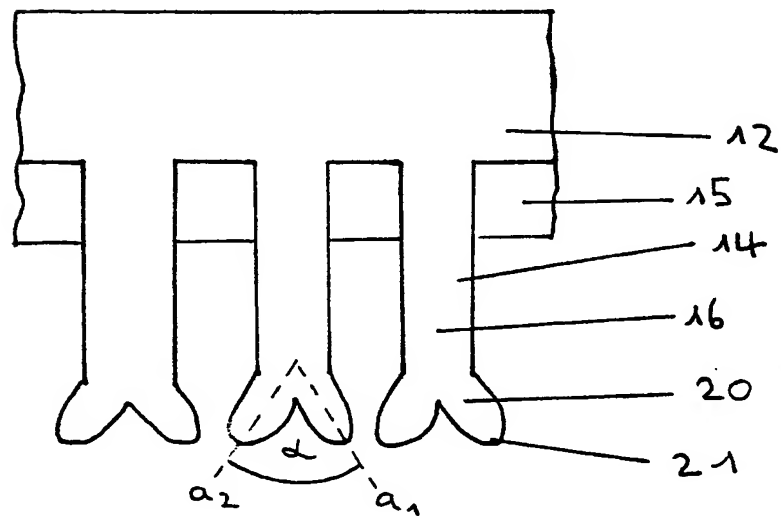


Fig. 6

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 99/05280

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 G01N21/65 G01J3/44

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 G01N G01J G03F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 485 425 A (MILNE CHRISTOPHER GEORGE ;SHELBY PAULUS PARKER JR (US); BAILEY DAV) 20 May 1992 (1992-05-20) cited in the application the whole document ---	1,7
A	EP 0 083 510 A (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO) 13 July 1983 (1983-07-13) the whole document ---	1,7
A	US 4 448 485 A (BERGMAN JOHN G ET AL) 15 May 1984 (1984-05-15) the whole document ---	1,7
A	US 4 802 951 A (CLARK NOEL A ET AL) 7 February 1989 (1989-02-07) the whole document ---	1,7
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

23 November 1999

Date of mailing of the international search report

02/12/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Navas Montero, E

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 99/05280

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>VO-DINH T: "SURFACE-ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY USING METALLIC NANOSTRUCTURES"</p> <p>TRAC, TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, GB, ANALYTICAL CHEMISTRY. CAMBRIDGE, vol. 17, no. 8/09, 1998, page 557-582</p> <p>XP000667508</p> <p>ISSN: 0165-9936</p> <p>paragraph '3.3.8.!</p> <p>-----</p>	7

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

II. National Application No

PCT/EP 99/05280

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0485425 A	20-05-1992	US 5017007 A	21-05-1991
		AU 648718 B	28-04-1994
		DE 69017031 D	23-03-1995
		AT 118611 T	15-03-1995
		AU 6147890 A	11-03-1991
		CA 2063830 A	28-01-1991
		JP 4506999 T	03-12-1992
		WO 9102228 A	21-02-1991
EP 0083510 A	13-07-1983	US 4407695 A	04-10-1983
		AU 550809 B	10-04-1986
		AU 9197482 A	07-07-1983
		CA 1196308 A	05-11-1985
		JP 58120255 A	18-07-1983
US 4448485 A	15-05-1984	NONE	
US 4802951 A	07-02-1989	US 4728591 A	01-03-1988

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/05280

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 G01N21/65 G01J3/44

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N G01J G03F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 485 425 A (MILNE CHRISTOPHER GEORGE ;SHELBY PAULUS PARKER JR (US); BAILEY DAV) 20. Mai 1992 (1992-05-20) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	1,7
A	EP 0 083 510 A (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO) 13. Juli 1983 (1983-07-13) das ganze Dokument	1,7
A	US 4 448 485 A (BERGMAN JOHN G ET AL) 15. Mai 1984 (1984-05-15) das ganze Dokument	1,7
A	US 4 802 951 A (CLARK NOEL A ET AL) 7. Februar 1989 (1989-02-07) das ganze Dokument	1,7

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

23. November 1999

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

02/12/1999

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Navas Montero, E

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>VO-DINH T: "SURFACE-ENHANCED RAMAN SPECTROSCOPY USING METALLIC NANOSTRUCTURES" TRAC, TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, GB, ANALYTICAL CHEMISTRY. CAMBRIDGE, Bd. 17, Nr. 8/09, 1998, Seite 557-582 XP000667508 ISSN: 0165-9936 Absatz '3.3.8.!</p> <p>-----</p>	7

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/05280

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0485425 A	20-05-1992	US 5017007 A	21-05-1991
		AU 648718 B	28-04-1994
		DE 69017031 D	23-03-1995
		AT 118611 T	15-03-1995
		AU 6147890 A	11-03-1991
		CA 2063830 A	28-01-1991
		JP 4506999 T	03-12-1992
		WO 9102228 A	21-02-1991
EP 0083510 A	13-07-1983	US 4407695 A	04-10-1983
		AU 550809 B	10-04-1986
		AU 9197482 A	07-07-1983
		CA 1196308 A	05-11-1985
		JP 58120255 A	18-07-1983
US 4448485 A	15-05-1984	KEINE	
US 4802951 A	07-02-1989	US 4728591 A	01-03-1988